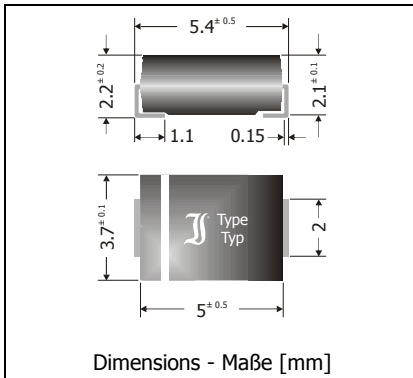


S2A ... S2Y
Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
Silizium-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage

Version 2011-10-24



Nominal Current – Nennstrom

2 A

Reverse voltage – Sperrspannung

50...2000 V

Plastic case

~ SMB

Kunststoffgehäuse

~ DO-214AA

Weight approx. – Gewicht ca.

0.1 g

Plastic material has UL classification 94V-0

Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped and reeled

Standard Lieferform gegurtet auf Rolle

**Maximum ratings and characteristics****Grenz- und Kennwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
S2A	50	50
S2B	100	100
S2D	200	200
S2G	400	400
S2J	600	600
S2K	800	800
S2M	1000	1000
S2T	1300	1300
S2W	1600	1600
S2X	1800	1800
S2Y	2000	2000

Max. average forw. rectified current – Dauergrenzstr. in Einwegschaltung	$T_T = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	2 A ¹⁾
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	10 A ²⁾
Surge current, 50/60 Hz half sine – Stoßstrom 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	50/55 A
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ – Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	12 A ² s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	-50...+150°C
Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 2\text{ A}$	V_F	< 1.15 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R I_R	< 5 µA < 100 µA
Thermal resistance junction to ambient – Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung		R_{thA}	< 50 K/W ²⁾
Thermal resistance junction-terminal – Wärmewiderstand Sperrschicht-Anschluss		R_{thT}	< 15 K/W

1 R-load – R-Last

2 Mounted on P.C. board with 50 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

